



Транзистор КТ827А, КТ827Б, КТ827В

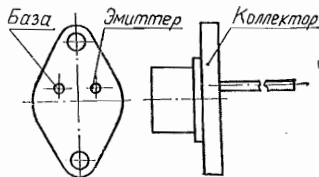
Э Т И К Е Т К А



Кремниевые меза-планарные *p-p-n* мощные транзисторы КТ827А, КТ827Б, КТ827В в металлокерамическом корпусе КТ-9 ГОСТ 18472-82 предназначены для работы в усилителях высокой частоты, стабилизаторах тока и напряжения, импульсных усилителях мощности, повторителях, переключателях, в электронных системах управления, защиты и автоматики аппаратуры.

Климатическое исполнение УХЛ, категории размещения 3.1, 5.1.

Масса транзистора не более 20 г



Основные электрические параметры при *T* corp. = (25 ± 10)°C

Табл. 1

Наименование параметров (режим измерения), единица измерения	Буквенное обозначен.	Норма	
		не менее	не более
Статический коэффициент передачи тока ($I_{кэ}=3 В, I_k=10 А$) ($I_{кэ}=3 В, I_k=20 А$)	$h_{21э}$	750	18000
		100	—
Обратный ток эмиттера ($I_{эб}=5 В$), мА	$I_{эб0}$	—	2
Обратный ток коллектор-эмиттер, мА ($R_{бэ}=1 кОм, I_{кэ}=100 В$), для КТ827А ($R_{бэ}=1 кОм, I_{кэ}=80 В$), для КТ827Б ($R_{бэ}=1 кОм, I_{кэ}=60 В$), для КТ827В	$I_{кэR}$	—	3
		—	3
		—	3
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер, ($I_k=10 А, I_b=0.04 А$), В	$I_{кэ нас}$	—	2
Напряжение насыщения база-эмиттер ($I_k=20 А, I_b=0.20 А$), В	$I_{бэ нас}$	—	4
Граничное напряжение ($I_k нас=300 мА, L=40 мГц, I_k=0.10 А$), В для КТ827А для КТ827Б для КТ827В	$I_{кэ0 гр}$	100	—
		80	—
		60	—
Модуль коэффициента передачи тока на высокой частоте ($f=10 мГц, I_{кэ}=3 В, I_k=10 А$)	$(h_{21э})$	0,4	—

Содержание драгоценных металлов в 1000 шт. транзисторов:

Золота — 16,8970 г

Содержание цветных металлов в 1000 шт. транзисторов:

Наименование цветного металла или сплава	Марка	Масса, г
Медь	МОб	2900

Сведения о приемке

Транзисторы КТ827А, КТ827Б, КТ827В соответствуют техническим условиям АА0.336.356ТУ.



Штамп ОТК

Штамп Государственной приемки



Указания по эксплуатации

Указания по применению и эксплуатации по ГОСТ 11630-84, ОСТ II 336.907.0-79 с дополнениями, изложенными ниже.

Транзисторы необходимо применять с теплоотводами. Крепление транзистора к теплоотводу должно обеспечивать надежный тепловой контакт.

Для улучшения теплового контакта необходимо наносить на нижнее основание корпуса транзистора жидкость ПМС-100 ГОСТ 13032-77 или другую теплопроводящую смазку.

При пайке выводов температура корпуса транзистора не должна превышать 100°С.

Т. 5000 3. 919-88